



広島大ナノデバイス・システム研究センター(東京大島市)の角南英夫教授(62) Ⅱ写真・半導体工学Ⅱが、電気電子工学の世界的権威である電気電子学会(IEEE、本部米国)の「ジュ

日本人初 DRAM大容量化 角南・広島大教授 ニシザワ賞受賞

ンイチ ニシザワ賞を受 開発した人に贈られる。 賞した。日本人では初の受 角南教授は日立製作所の 賞。 研究員だった一九七五年、 同賞は現在、首都大学東 DRAM(記憶保持動作が 京学長を務める西沢潤一氏 必要な随時書き込み読み出 が半導体装置の発展に寄与 しメモリ)の基板に溝を した功績をたたえ、二〇〇 掘ることで、大容量化を美 二年に創設。エレクトロニ 現した点が評価された。 (藤原直樹)

日本人3人が初受賞

「IEEE西澤潤一メダル」



角南広島大教授

米国電気電子技術者協会(IEEE)は15日、コンピュータ・メモリ技術を革新した角南英夫広島大大学教授、小柳光正東北大大学教授、伊藤清男日立製作所フェローの日本人3人に、06年IEEE西澤潤一メダルを授与すると発表した。日本人の受賞は初めて。24日に米ミネソタ州で授賞式が開かれる。

DRAM技術革新に貢献



小柳東北大教授

角南教授は現在、DRAM製品に広く使われている、極めて高い信号対雑音比を実現するトレンチ・キャパシタセルを発明した。小柳教授はDRAMセルの構造に使われているスタック・キャパシタセルを発明。伊藤日立フェローはDRAMチップに採用されている折り返しデータ線配置セルの概念を編み出した。 同賞は材料とデバイス科学技術に多大な貢献をした人に授与される。西澤潤一 首都大学東京学長の半導体基礎材料や光通信などの幅広い業績をたたえるために創設された。第1回(04年)、第2回(05年)とも元IBMの研究者が受賞しており、3回目の今年、初めて日本人が栄誉に輝いた。



伊藤日立フェロー

「西澤メダル」日本人3氏に

米電気電子学会(IEEE)は、画期的な材料や素子を開発した研究者に贈る「西澤潤一メダル」の受賞者を、角南英夫・広島大教授、小柳光正・東北大教授、伊藤清男・日立製作所フェローの3人に決めた。24日、米国で授与される。

3人は、DRAMというメモリーの性能を高める新技術をそれぞれ70年代に発明。その成果は現在の製品にも生かされているという。同メダルは、西澤潤一・首都大学東京学長の業績をたたえ、02年に創設された。

◆「西沢メダル」に日本人研究者3人 米国電気電子学会(IEEE)は14日、半導体分野などの優れた研究者を表彰する「西沢潤一メダル」を、角南英夫・広島大教授、小柳光正・東北大教授、伊藤清男・日立製作所フェローの3人に授与すると発表した。DRAM(記憶保持動作が必要な随時書き込み読み出しメモリ)の欠陥やノイズを低減するのに必要な製造技術を開発した功績などが評価された。日本人の受賞は今回が初めて。

日経産業新聞

日立フェローが西沢メダル受賞

日立製作所は十五日、同社フェローの伊藤清男氏らが米国電気電子学会(IEEE)の西沢メダルを受賞することになったと発表した。同社出身で広島大学教授の角南英夫氏と、東北大学教授の小柳光正氏との共同受賞。

受賞理由は「DRAMメモリセルとアーキテクチャの先駆的貢献」で、一九七〇―八〇年代に同社中央研究所が開発したメモリの基本技術。西沢メダルを日本人が受賞するのは今回が初めて。